
	<p>SI2300DS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2300DS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 3.6A SOT-23</p> <p>Datenblätter:  SI2300DS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 163105 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2300DS-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.6A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	163105 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	68 mOhm @ 2.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	320pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)































SI2300DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2300DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2300DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2300DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI2301 (A1) Original SOT-23	 SI2300DS-T1-E3 VISHAY SI2300DS-T1-E3 VISHAY	 SI2300DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.6A SOT-23	 SI2300DS VISHAY SI2300DS VISHAY
 SI2300BDS-T1-E3 VISHAY SI2300BDS-T1-E3 VISHAY	 SI2300BDS-T1-GE3 VISHAY SI2300BDS-T1-GE3 VISHAY	 SI2301 VISHAY SI2301 VISHAY	 SI2300DS-TI-E3 VISHAY SI2300DS-TI-E3 VISHAY

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  SI2163-D-GMR |  SI2163-GM |  SI2165-C-FM |  SI2165-D-GMR |  SI2165-FM |
|  SI2165-GM |  SI2167-B20-GMR |  SI2168-A30-GMR |  SI2169-B40-GMR |  SI2172-A10-GMR |
|  SI2172-A20-GM |  SI2172-A20-GMR |  SI2173-A30-GMR |  SI2173-A40-ZM7R |  SI2176-B30-GMR |
|  SI2176-B30-ZM7R |  SI2176-B30-ZM8R |  SI2178-A20-GMR |  SI2191-A20-ZM7R |  SI2196-A0A-GMR |
|  SI2300/AE9T |  SI2300BDS-T1-GE3 |  SI2300DS |  SI2300DS-T1 |  SI2300DS-T1-E3 |
|  SI2300DS-T1-GE3 |  SI2300DS-TI-E3 |  SI2301-TP |  SI2301A1SHB |  SI2301ADS |
|  SI2301ADS-T1-E3 |  SI2301ADS-T1-GE3 |  SI2301BDS |  SI2301BDS-E3 |  SI2301BDS-T1 |
|  SI2301BDS-T1-E3 |  SI2301BDS-T1-E3 |  SI2301BDS-T1-GE3 |  SI2301BDS-T1-GE3 |  SI2301CDS |
|  SI2301CDS-T1-E3 |  SI2301CDS-T1-E3 |  SI2301CDS-T1-GE3 |  SI2301CDS-T1-GE3 |  SI2301DS |
|  SI2301DS-E3 |  SI2301DS-T1 |  SI2301DS-T1-E3 |  SI2301DS-T1-GE3 |  SI2302ADS |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited